

**КТ8232 А, Б. N-P-N КРЕМНИЕВЫЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОЩНЫЙ СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР**

Предназначен для применения в переключающих и импульсных схемах. Идеально подходит для электронных систем зажигания.

Имеет встроенный диод в цепи коллектор - эмиттер и схему защиты от вторичного пробоя, $R_1 \approx 800 \text{ Ом}$,

$R_2 \approx 80 \text{ Ом}$.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра	Обозначение	Величина	Ед. изм.
Напряжение коллектор-эмиттер ($I_B=0$)	U_{CEO}	350. . гр.А 300. . гр.Б	В
Напряжение эмиттер-база ($I_C=0$)	U_{EBO}	5	В
Постоянный ток коллектора	I_C	20	А
Импульсный ток коллектора	I_{CM}	30	А
Постоянный ток базы	I_B	3	А
Импульсный ток базы	I_{BM}	5	А
Постоянная рассеиваемая		125*	Вт

мощность	P_D		
Энергия пробоя на индуктивную нагрузку	E	350	мДж
Диапазон рабочих температур перехода	ΔT_j	-60 до +150	°C
Максимальная температура перехода	T_{jmax}	+150	°C

* при $T_k = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

Электрические характеристики

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Величина		Режим измерения
			Мин.	Макс.	
Граничное напряжение коллектор-эмиттер ($I_C=100$ мА)	$U_{CEO(sus)}$	В	350 250	500 350	группа А группа Б
Обратный ток коллектор-эмиттер ($I_B=0$)	I_{CEO}	мА		0.1 0.1	$U_{CE}=300$ В (А) $U_{CE}=250$ В (Б)
Обратный ток эмиттер-база ($I_C=0$)	I_{EBO}	мА		20	$U_{EB}=5$ В
Статический коэффициент передачи тока	h_{FE}^{**}		300		$I_C=5$ А, $U_{CE}=10$ В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{CE(sat)}^{**}$	В		1.8 1.8	$I_C=8$ А, $I_B=0.1$ А $I_C=10$ А, $I_B=0.25$ А

				2.0	$I_C=12$ А, $I_B=0.3$ А
Напряжение насыщения база-эмиттер	$U_{BE(sat)}^{**}$	В		2.2 2.5 2.7	$I_C=8$ А, $I_B=0.1$ А $I_C=10$ А, $I_B=0.25$ А $I_C=12$ А, $I_B=0.3$ А
Прямое напряжение на диоде	U_F	В		2.5	$I_F=10$ А

** измерение данных параметров проводится в импульсном режиме: длительность импульсов 300 мкс, скважность 1.5 %.

Близкими аналогами транзисторов КТ8232 А, Б являются приборы ВU941ZP (SGS-Thomson), а также КТ898 А, Б.

Преимущество КТ8232 А, Б - повышенная устойчивость транзистора к вторичному пробоя при работе на индуктивную нагрузку. Типовое значение энергии вторичного пробоя - $E=1$ Дж.